



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H557

对应国外型号
BC557

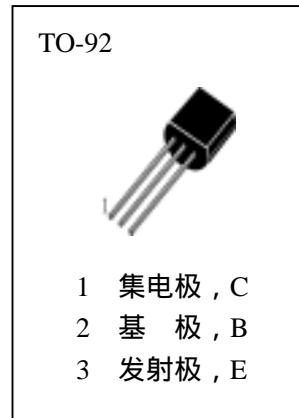
主要用途

开关、视频放大。

极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极耗散功率.....	500mW
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	-50V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	-45V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	-5V
I_C ——集电极电流.....	100mA

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最 小 值	典 型 值	最大 值	单 位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-50			V	$I_C=-100 \mu\text{A}, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-45			V	$I_C=-10\text{mA}, I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_E=-100 \mu\text{A}, I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-15	nA	$V_{CB}=-30\text{V}, I_E=0$
H_{FE}	直流电流增益	110		800		$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-2\text{mA}$
$V_{CE(sat1)}$	集电极—发射极饱和电压		-90	-300	mV	$I_C=-10\text{mA}, I_B=-0.5\text{mA}$
$V_{CE(sat2)}$			-250	-650	mV	$I_C=-100\text{mA}, I_B=-5\text{mA}$
$V_{BE(sat1)}$	基极—发射极饱和电压		-700		mV	$I_C=-10\text{mA}, I_B=-0.5\text{mA}$
$V_{BE(sat2)}$			-900		mV	$I_C=-100\text{mA}, I_B=-5\text{mA}$
$V_{BE(on1)}$	基极—发射极导通电压		-660	-750	mV	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-2\text{mA}$
$V_{BE(on2)}$				-800	mV	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-10\text{mA}$
f_T	特征频率		150		MHz	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-10\text{mA}, f=1\text{MHz}$
C_{ob}	输出电容			6	pF	$V_{CE}=-10\text{V}, I_C=0, f=1\text{MHz}$

分档及其标志

A

B

C

110—220

200—450

420—800